

30 ECTS

Modulbezeichnung: Materialien der Elektronik und Energietechnik mit

Vertiefung Crystal Growth (M1 CG WW6)

(Materials for Electronics and Energy Technology especially Crystal

Growth)

Modulverantwortliche/r: Christoph J. Brabec

Lehrende: Peter Wellmann, Christoph J. Brabec, Miroslaw Batentschuk, Wolfgang Heiß, Uwe

Scheuermann

Startsemester: WS 2020/2021 Dauer: 2 Semester Turnus: jährlich (WS) Präsenzzeit: 345 Std. Eigenstudium: 555 Std. Sprache: Deutsch

Lehrveranstaltungen:

Materialien und Bauelemente für die Optoelektronik und Energietechnologie: Grundlagen (WS 2020/2021, Vorlesung, 2 SWS, Christoph J. Brabec)

Crystal Growth 1 - Fundamentals of Crystal Growth and Semiconductor Technology (WS 2020/2021,

Vorlesung, 2 SWS, Peter Wellmann)

Praktikum Wahlfach Crystal Growth (WS 2020/2021, Praktikum, 3 SWS, Peter Wellmann)

Materialien und Bauelemente für die Optoelektronik und Energietechnologie: Anwendung (SS 2021,

Vorlesung mit Übung, 2 SWS, Christoph J. Brabec)

Halbleitercharakterisierung (SS 2021, Vorlesung, 2 SWS, Wolfgang Heiß)

Exkursionen (SS 2021, Exkursion, Peter Wellmann)

Crystal Growth 2 - Electronic Devices & Materials Properties/Processing, Epitaxial Growth (SS 2021, Vorlesung, 2 SWS, Peter Wellmann)

Grundlagen der Halbleiterphysik (WS 2020/2021, Vorlesung, 2 SWS, Wolfgang Heiß)

Kernfachpraktikum I Werkstoffe der Elektronik und der Energietechnologie (SS 2021, Praktikum, 3 SWS, Miroslaw Batentschuk et al.)

Wahlvorlesungen

Aus den optionalen Wahlveranstaltungen können Vorlesungen gewählt werden, die mit 3 ECTS in das Modul eingehen.

Leuchtstoffe / Phosphors (SS 2021, optional, Vorlesung, 2 SWS, Miroslaw Batentschuk et al.)

Crystal Growth 2 - Wide Bandgap Semiconductors (SS 2021, optional, Vorlesung, 1 SWS, N.N.)

Kolloidale Nanokristalle (SS 2021, optional, Vorlesung, 2 SWS, Wolfgang Heiß)

Aufbau- und Verbindungstechnik in der Leistungselektronik (WS 2020/2021, optional, Vorlesung, 2 SWS, Uwe Scheuermann)

Inhalt:

Materialien und Bauelemente für die Optoelektronik und Energietechnologie: Grundlagen und Anwendungen (Brabec, Matt)

- Grundlagen der Festkörper- und Halbleiterphysik mit Schwerpunkt auf anorganische und organische Halbleitermaterialien
- Grundlagen und Anwendungen der optoelektronischen Bauelemente der erneuerbaren Energietechnologie, mit Schwerpunkt auf Energieerzeuger (Solarzellen), Energiekonverter (z.B. anorganische und organische LEDs), Energiespeicher (Batterien, Brennstoffzelle, Supraleiter)

Grundlagen des Kristallwachstums und der Halbleitertechnologie (Wellmann)

- Grundlagen des Kristallwachstums
- Grundlagen der Silizium Halbleitertechnologie (Oxidation, Dotierung mittels Diffusion und Ionenimplantation, Ätzen, Metallisierung, Lithografie Packaging

Praktikum Crysatl Growth (Wellmann)

- Czochralski Kristallwachstum von InSb
- Modellierung in der Kristallzüchtung
- Halbleitercharakterisierung

Halbleitercharakterisierung (Osvet, Forberich, Matt, Meißner, Batentschuk)

- Physikalische Grundlagen
- Messmethoden (bildgebende Verfahren, Bestimmung der Realstruktur, optische und elektrische Charakterisierung, chemische Analysemethoden

UnivIS: 02.06.2024 03:49



Elektronische Bauelemente und Materialfragen (Wellmann)

- Korrelation von Bauelementfunktion (Bipolar-Diode, Bipolar-Transistor, Schottky-Diode, Feldeffekt-Transistor, Leucht- und Laserdiode) mit Materialeigenschaften
- Grundlagen Epitaxie

Grundlagen der Halbleiterphysik (Heiss)

- Bindungen und Kristallstruktur
- Bänder, Bandlücken und Bandstruktur
- Ladungsträgerstatistik und Dotierung
- Elektrischer Transport
- Einfache Bauelemente vom Ohmschen Kontakt zur Diode
- Optische Eigenschaften von Halbleitern
- Elektro-Optische Bauteile

Kernfachpraktikum (Batentschuk)

- Transporteigenschaften in Halbleitern
- Optische Eigenschaften von Leuchtstoffen und Halbleitern
- Thermoelektrizität

Lernziele und Kompetenzen:

- Die Studierenden verstehen die Zusammenhänge zwischen Herstellungsmethoden von Halbleiter und Isolatoren und deren chemischen und physikalischen Eigenschaften.
- Die Studierenden k\u00f6nnen ihre Kenntnisse zu physikalischen und chemischen Eigenschaften von Halbleitern und Isolatoren und zu Herstellung der Kristalle f\u00fcr die Analyse auf dem Stand der Technik, f\u00fcr die Evaluierung und Beurteilung der Vorteile der verschiedenen Herstellungsmethoden bzw. f\u00fcr die Entwicklung neuer Technologien im Bereich Bauelemente und erneuerbaren Energietechnologie anwenden.
- Die Studierenden können die Anwendbarkeit von optoelektronischen Bauelementen für diverse Energietechnologien selbständig beurteilen .

Literatur

Wird in den Lehrveranstaltungen angegeben.

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:

Das Modul ist im Kontext der folgenden Studienfächer/Vertiefungsrichtungen verwendbar:

[1] Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Master of Science)

(Po-Vers. 2010 | TechFak | Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Master of Science) | Gesamtkonto | Module M1 - M3 (gegliedert nach Kernfächern) | Kernfach Werkstoffe in der Elektrotechnik | 1. Werkstoffwissenschaftliches Modul (M1) | Materialien der Elektronik und Energietechnik)

[2] Nanotechnologie (Master of Science)

(Po-Vers. 2015w | TechFak | Nanotechnologie (Master of Science) | Gesamtkonto | Kernfachmodul aus MWT, EEI, CBI, Ph, Ch | Kernfachmodul MWT | Materialien der Elektronik und Energietechnik)

Studien-/Prüfungsleistungen:

Materialien der Elektronik und Energietechnik mit Vertiefung Crystal Growth (Prüfungsnummer: 62902) (englische Bezeichnung: Materials for electronic and energy technology with special crystal growth)

Prüfungsleistung, mündliche Prüfung, Dauer (in Minuten): 40

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100%

weitere Erläuterungen:

Alternative Prüfungsform laut Corona-Satzung: Die mündliche Prüfung findet als digitale Fernprü-

fung per ZOOM statt. Prüfungssprache: Deutsch

Erstablegung: SS 2021, 1. Wdh.: WS 2021/2022

1. Prüfer: Christoph J. Brabec

UnivIS: 02.06.2024 03:49



Unbenoteter Schein Materialien der Elektronik und Energietechnik (Prüfungsnummer: 62901)

(englische Bezeichnung: Ungraded Credit: Materials in Electronics and Electrical Engineering)

Studienleistung, Praktikumsleistung

weitere Erläuterungen:

Es besteht Anwesenheitspflicht. Verbindliche Zulassungsvoraussetzung zum Praktikum ist die Teilnahme an der zugehörigen Sicherheitsbelehrung. Verbindliche Teilnahmevoraussetzung für jeden einzelnen Praktikumsversuch ist die erfolgreiche Erledigung des Vorprotokolls (Antestat). Das Praktikum ist nur bestanden, wenn alle Versuche sowie alle Vor- und Nachprotokolle erfolgreich absolviert wurden, d.h. die vollständig ausgefüllte Testatkarte mit Nachweisen für Vorprotokolle (Antestate) sowie für Versuchsdurchführungen und Nachprotokolle (Abtestate) fristgerecht im Sekretariat des Lehrstuhls WW6 (R3.66 Martensstr. 7) vorgelegt wurde.

Prüfungssprache: Deutsch und Englisch

Erstablegung: SS 2021, 1. Wdh.: WS 2021/2022

1. Prüfer: Peter Wellmann

UnivIS: 02.06.2024 03:49